



Рис. 5. Зависимости ширины области захвата от h и η при начальном положении $\Delta\omega > 0$.

ниях движения частоты ω_{ext} . Сопоставление кривых на рис. 4 и 5 также свидетельствует о гистерезисном характере зависимостей $|\omega_m - \omega_{\text{ext}}|_{\text{max}}/2\pi$.

С приближением частоты модуляции накачки к релаксационной частоте автомодуляционный режим, как и следовало ожидать, сменился режимом динамического хаоса. Область захвата (область частот $\omega_r - \omega_{\text{ext}}$, внутри которой существовал режим динамического хаоса) в этом случае оказалась порядка 10 кГц.

4. Заключение

Таким образом, в результате проведенных экспериментальных исследований установлено, что при периодической модуляции излучения накачки твердотельного кольцевого лазера, работающего в автомодуляционном режиме, область захвата автомодуляционной частоты частотой внешней силы (т.е. область, внутри которой частота автомодуляции оказывается равной частоте внешнего воздействия) может достигать нескольких десятков кГц. При этом захват частоты имеет место только в том случае, когда частота автомодуляции больше частоты внешнего воздействия.

Авторы благодарны Н.И.Наумкину и С.Н.Чекиной за помощь в проведении экспериментов. Работа поддержана РФФИ (гранты № 02-02-16391 и 02-02-06203).

1. Кравцов Н.В., Ларионцев Е.Г. *Квантовая электроника*, **30**, 105 (2000).
2. Кравцов Н.В., Ларионцев Е.Г., Наумкин Н.И., Сидоров С.С., Фирсов В.В., Чекина С.Н. *Квантовая электроника*, **31**, 189 (2001).
3. Хандохин П.А., Ханин Я.И. *Квантовая электроника*, **11**, 1483 (1984).
4. Золотоверх И.И., Кравцов Н.В., Ларионцев Е.Г., Макаров А.А., Фирсов В.В. *Квантовая электроника*, **22**, 213 (1995).
5. Золотоверх И.И., Кравцов Н.В., Кравцов Н.Н., Ларионцев Е.Г., Макаров А.А. *Квантовая электроника*, **24**, 638 (1997).
6. Золотоверх И.И., Кравцов Н.В., Ларионцев Е.Г. *Квантовая электроника*, **23**, 625 (1996).

ПОПРАВКИ

П.В.Булаев, О.И.Говорков, И.Д.Залевский, В.Г.Кригель, А.А.Мармалюк, Д.Б.Никитин, А.А.Падалица, А.В.Петровский. Влияние особенностей гетероструктур с квантовыми ямами InGaAs/(Al)GaAs, полученных методом МОС-гидридной эпитаксии, на спектр излучения одномодовых лазерных диодов («Квантовая электроника», 2002, т. 32, № 3, с. 216–218).

В статье допущена следующая опечатка: на с. 217 в левой колонке на 3-й строке снизу вместо «... в работах [3, 4]. ...» следует читать «... в работах [2–4]. ...».

В.И.Козловский, Х.Х.Кумыков, И.В.Мальшев, Ю.М.Попов. Температурный режим работы лазерного экрана электронно-лучевой трубки («Квантовая электроника», 2002, т. 32, № 4, с. 297–302).

В статье допущена следующая опечатка: на с. 300 в подрисуночной подписи к рис. 4 вместо « $L_c = 5$ мкм. ...» следует читать « $L_c = 15$ мкм. ...».

В.Д.Курносков, К.В.Курносков, Р.В.Чернов. Исследование характеристик одночастотных полупроводниковых лазеров в системе GaAs/AlGaAs («Квантовая электроника», 2002, т. 32, № 4, с. 303–307).

В статье допущены следующие опечатки:

1. На с. 304 формула (9) должна иметь следующий вид:

$$v_{\text{gr}} \left[\Gamma_a g(E_m) - \varepsilon_m S_m - \sum_{q \neq m} D_q S_q - \alpha \right] S_m + \beta R_{\text{sp}} = 0, \quad (9)$$

2. На с. 305 в правой колонке на 3-й строке снизу вместо «... 4×10^{16} см²» следует читать «... 4×10^{-16} см²».